RADIATION SENSITIVE RESIN COMPOSITION

Publication number: JP5002267
Publication date: 1993-01-08

Inventor: MIYASHITA SATOSHI; ISAMOTO YOSHITSUGU;

MIURA TAKAO

Applicant:

JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD

Classification:

- international: G03F7/022; H01L21/027; G03F7/022; H01L21/02;

(IPC1-7): G03F7/022; H01L21/027

- European:

Application number: JP19910199889 19910716

Priority number(s): JP19910199889 19910716; JP19910078310 19910319

Report a data error here

Abstract of JP5002267

PURPOSE:To provide a radiation sensitive resin compd. which gives high resolution, good developing property, excellent focus allowance and pattern forming property, and from which a positive resist excellent in storage stability can be obtd. CONSTITUTION:The radiation sensitive resin compd. contains an alkali-soluble novolac resin, 1,2-quinonediazide compd. and a solvent. The solvent has a structure expressed by formula R<1>-CO-Y-CO2R<2> ... [I]. In formula I, R<1> and R<2> are alkyl groups of 1-3 carbon number, Y is an alkylene group of single bond or 1-3 carbon number.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-2267

(43)公開日 平成5年(1993)1月8日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

FΙ 庁内整理番号

技術表示箇所

G03F 7/022

7124-2H

H01L 21/027

7352-4M

H 0 1 L 21/30

301 R

審査請求 未請求 請求項の数1(全 14 頁)

(21)出願番号

特願平3-199889

(71)出願人 000004178

日本合成ゴム株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)7月16日

東京都中央区築地2丁目11番24号

(31) 優先権主張番号 特願平3-78310

(32)優先日

平3 (1991) 3月19日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(72) 発明者 宮下 聡

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 勇元 喜次

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(72)発明者 三浦 孝夫

東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合

成ゴム株式会社内

(74)代理人 弁理士 大島 正孝

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【目的】高解像度で現像性が良好で、かつフォーカス許 容性とパターン形状に優れ、しかも保存安定性に優れた ポジ型レジストを得ることができる感放射線性樹脂組成 物を提供する。

R1-C0-Y-C02R2

*【構成】アルカリ可溶性ノボラック樹脂、1,2-キノ ンジアジド化合物および溶剤を含有する感放射線性樹脂 組成物において、該溶剤が下記一般式(I)

【化1】

... [1]

ここで、 R^1 および R^2 は炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を表わし、Yは単結合 または炭素数1~3のアルキレン基を表わす、

で表わされる構造を有することを特徴とする感放射線性

樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アルカリ可溶性ノボラック樹脂、1,2 ーキノンジアジド化合物および溶剤を含有する感放射線* R1-C0-Y-C02R2

*性樹脂組成物において、該溶剤が下記一般式(I) 【化1】

...[1]

ここで、R¹およびR²は炭素数1~3のアルキル基を表わし、Yは単結合 または炭素数1~3のアルキレン基を表わす、

で表わされる構造を有することを特徴とする感放射線性 10%てきた。この様な状況において、高解像度で現像性が良 樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は感放射線性樹脂組成物に 関し、詳しくは紫外線、遠赤外線、X線、電子線、分子 線、γ線、シンクロトロン放射線、プロトンビームなど の放射線に感応する高集積回路を作製する為のポジ型レ ジストに関し、さらに詳しくはi線(365nmの紫外 線光) およびg線(436nmの紫外線光)に感応する 高集積回路を作製するためのポジ型レジストとして好適 20 【0004】 な感放射線性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ポジ型レジストは高解像度のレジストパ ターンが得られるので、集積回路の製造において多く用 いられている。ところで、半導体技術の進歩に伴い、ま すます、高集積化、すなわち、微細化が進み今や0.5 μmからそれ以下のサブミクロンの解像度が必要になっ※ R1-C0-Y-C02R2

好で、かつフォーカス許容性とパターン形状に優れ、し かも保存安定性に優れたポジ型レジストに対する要求 は、非常に強い。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高解 像度で現像性が良好で、かつフォーカス許容性とパター ン形状に優れ、しかも保存安定性に優れたポジ型レジス トを得ることができる感放射線性樹脂組成物を提供する ことにある。

【課題を解決するための手段】本発明の感放射線性樹脂 組成物は アルカリ可溶性ノボラック樹脂、1,2-キ: ノンジアジド化合物および溶剤を含有する感放射線性樹土 脂組成物において、該溶剤が下記一般式(Ⅰ)

[0005]

【化2】

... [1]

ここで、R¹およびR²は炭素数1~3のアルキル基を表わし、Yは単結合 または炭素数1~3のアルキレン基を表わす、

【0006】で表わされる構造を有することを特徴とす る。

【0007】本発明の感放射線性組成物(以下単に「組 成物」という)は、溶剤として、上記一般式(I)で表 わされる構造を有する溶剤を含有する。一般式(I)中 R1およびR2は同一もしくは異なり炭素数1~3のアル 基、 n ープロピル基または i s o ープロピル基のいずれ かである。またYは単結合または炭素数1~3のアルキ レン基である。かかるアルキレン基はメチレン基、1, 1-エチレン基、1,2-エチレン基、1,3-プロピレ ン基、1,2-プロピレン基、1,1-プロピレン基また は2.2-プロピレン基である。

【0008】一般式(I)で表わされる構造を有する溶 剤としては、例えば、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エ チル、ピルピン酸プロピル、アセト酢酸メチル、アセト 酢酸エチル、2-オキソプタン酸メチル、2-オキソプ 50 類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類;メチル

タン酸エチル等を挙げることができる。これらの溶剤の うち、ピルビン酸エチル、アセト酢酸メチルおよびアセ ト酢酸エチルが好ましい。

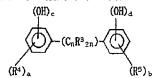
【0009】一般式(I)で表わされる構造を有する溶 剤は単独で用いることもできるが、他の溶剤と混合して 用いることもできる。他の溶剤としては、例えば、エチ キル基を表わす。かかるアルキル基はメチル基、エチル 40 レングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類:メチ ルセロソルプアセテート、エチルセロソルプアセテート 等のエチレングリコールアルキルエーテルアセテート 類;ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチ レングリコールモノエチルエーテル等のジエチレングリ コール類:プロピレングリコールメチルエーテルアセテ ート、プロピレングリコールエチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールプロピルエーテルアセテート 等のプロピレングリコールアルキルエーテルアセテート

.3

エチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類:2-ヒ ドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオ ン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸 エチル、メチルー3-メトキシプロピオネート、エチル -3-メトキシプロピオネート、メチル-3-エトキシ プロピオネート、エチルー3-エトキシプロピオネー ト、エトキシ酢酸エチル、オキシ酢酸エチル、2-ヒド ロキシー3-メチルブタン酸メチル、3-メチル-3-メトキシプチルアセテート、3-メチル-3-メトキシ プチルプロピオネート、3-メチル-3-メトキシブチ 10 ルプチレート、酢酸エチル、酢酸プチル等のエステル類 を挙げることができる。

【0010】 さらにベンジルエチルエーテル、ジヘキシ ルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチ レングリコールモノプチルエーテル、アセトニルアセト ン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オクタ ノール、1-ノナノール、ベンジルアルコール、酢酸ベ ンジル、安息香酸エチル、シュウ酸ジエチル、マレイン プロピレン、フェニルセロソルプアセテート等の高沸点 溶剤を添加することもできる。これらの溶剤は1種また は2種類以上使用してもよい。

【0011】本発明においては、これら溶剤の全量のう ち、一般式 (I) で表わされる構造を有する溶剤の占め る割合は50%以上が好ましい。一般式(I)で表わさ*



*れる溶剤の占める割合が50%未満であると、保存安定 性が低下する。

【0012】本発明の組成物においては、前期アルカリ 可溶性ノボラック樹脂としては、好ましくはm-クレゾ ール、p-クレゾールまたは一般式(A)で表わされる フェノール類をアルデヒド類と重縮合させたノボラック 樹脂が使用される。m-クレゾールとp-クレゾールと 下記一般式(A)

[0013]

【化3】



ここでmは2または3である、

【0014】で表わされるフェノール類を、添付図面の 図1の点A、B、C、DおよびEで囲まれた斜線部分、 酸ジエチル、 γ - プチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸 20 好ましくは点 Γ 、 Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ 示した割合(モル比)で用い、これらをアルデヒド類と 重縮合させた樹脂(以下、単に「樹脂A」という)ある いはかかる樹脂A60重量部以上と下記一般式(B) [0015]

新期广告: 0.8.8 ~ 4 - 37 N V 治は...

... (B)

、【化4】

ここで、R3、R4およびR5は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素 数1~3のアルキル基、アルコキシ基、芳香環を1~2個有し且つ置換基 を有していてもよい芳香族基を表わし、a、b, c, dおよびnは同一も しくは異なり、0~3の整数である。但しc+d=1~4である、

【0016】で表わされる化合物B40重量以下との混 合物、好ましくは樹脂A60~95重量部と化合物B4 ~95重量部と化合物B30~5重量部との混合物が使 用される。

【0017】一般式(A)で表わされるフェノール類 (以下、単に「フェノール類A」という) としては、例 えば2,3-キシレノール、2,4-キシレノール、2, 5-キシレノール、2,6-キシレノール、3,4-キシ レノール、3,5-キシレノール、2,3,4-トリメチ ルフェノール、2,3,5-トリメチルフェノール、3, 4,5-トリメチルフェノール等を挙げることができ る。これらのフェノール類は2種以上混合して使用する 50 【0020】

こともできる。

【0018】 m-クレゾールの使用割合が20モル%未 0~5重量部との混合物、さらに好ましくは樹脂A70 40 満では、現像性および保存安定性が悪化し易く、95モ ル%を越えるとパターン形状、解像度が悪化し易くな る。p-クレゾールの使用割合が60モル%を越えると 解像度、パターン形状、現像性が悪化し易くなる。フェ ノール類Aの使用割合が80モル%を越えると現像性、 保存安定性が悪化し易くなる。

> 【0019】一般式(B)で表わされる化合物B(以 下、単に「化合物B」という)としては、例えば以下の 構造式で表わされる化合物を使用することができる。化 合物Bは、2種以上混合して使用することもできる。

【化5】

5

(HO), (HO)(CH3), (CH₃)

$$(H0)_a \qquad (OH)_b \qquad (H0)_a \qquad (OH)_b \qquad (OH)_a \qquad ($$

$$(H0)_a \qquad CH_3 \qquad CH_3 \qquad CH_3 \qquad (CH_3)_x \qquad (CH_3)_y \qquad ($$

(OH)_ь (HO) CH^3 (HO) (CH_3) (CH₃Y_x (CH₃) ,

[0021]

 f_{σ}, f_{σ} $f(x) = \frac{d(x)}{dx} \in \mathbb{R}^{2n}$

> (CH₃); (OH) (CH₃)₌ (OH)_b

上記式中において、a, bおよびcは各々0~3であり(ただし、すべて が0ではあり得ない) そしてx, yおよびzは各々0~3である(但し、 (a+x)、(b+y) および(c+z) はいずれも4を超えない)。

[化6]

【0022】化合物Bのうち、1,1-ピス(2-ヒド ロキシフェニル) メタン、1-(2-ヒドロキシフェニ ル) -1-(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1 ービス (4ーヒドロキシフェニル) メタン、1,1ービ ス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、2,2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) プロパン、1,1,1-トリ 50 1-トリス (2-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1

ス(2-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1-ピス (2-ヒドロキシフェニル)-1-(4-ヒドロキシフ ェニル) メタン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニ ル) -1-(2-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1, 1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) メタン、1,1,

) JE 125

ーピス (2ーヒドロキシフェニル) -1- (4ーヒドロ キシフェニル) エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -1- (2-ヒドロキシフェニル) エタン、 1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、 1.1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-[4-{1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチ ル) フェニル] エタン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ フェニル) -1-フェニルエタン、1,1-ピス(2-ヒドロキシフェニル) -1-フェニルエタン、1,1-ピス (4-ヒドロキシフェニル) -1-フェニルメタ 10 00 \mathbb{C} 、好ましくは、 $70\sim130$ \mathbb{C} である。 ン、1,1-ビス(2-ヒドロキシフェニル)-1-フ ェニルメタン等が好ましい。

【0023】樹脂Aと化合物Bとを混合して使用する場 合に、樹脂Aの使用割合が60重量部未満では、現像 性、フォーカス許容性、保存安定性が悪化し易く、95 重量部を越えると、解像度、パターン形状が悪化し易く なる。化合物 Bの使用割合が 5 重量部未満では、解像 度、パターン形状が悪化し易く、40重量部を越える と、現像性、フォーカス許容性、保存安定性が悪化し易 くなる。

【0024】樹脂Aの重縮合に使用されるアルデヒド類 としては、例えばホルムアルデヒド、ベンズアルデヒ ド、フルフラル、アセトアルデヒド等を挙げることがで き、これらのアルデヒド類のうち、特にホルムアルデヒ ドが好ましい。これらのアルデヒド類は単独でまたは2 種以上組み合わせて用いることができる。アルデヒド類 の使用割合は、m-クレゾールとp-クレゾールとフェ ノール類Aの総量1モルに対し、0.7~3モルが好ま しく、より好ましくは0.75~1.3モルである。

ては、例えば塩酸、硝酸、硫酸、ギ酸、シュウ酸、酢酸 等を挙げることができる。

【0026】本重縮合においては、通常、反応媒質とし ては水が用いられ、この場合、酸性触媒の使用量は、通 常、m-クレゾールとp-クレゾールとフェノール類A の総量1モルに対し、1×10⁻⁵~5×10⁻¹モルであ る。また、反応媒質として親水性溶媒を使用する場合の 酸性触媒の使用量は、通常、m-クレゾールとp-クレ ゾールとフェノール類Aの総量1モルに対し、1×10

(H0)

-4~5 モルである。

【0027】ここで、親水性溶媒としては、例えばメタ ノール、エタノール、プロパノール、ブタノール等のア ルコール類、または、テトラヒドロフラン、ジオキサン 等の環状エーテル類等が挙げられる。これらの反応媒質 の使用量は、通常、反応原料100重量部当たり、20 ~1000重量部である。

【0028】重縮合の反応温度は、反応原料の反応性に 応じて、適宜調整することができるが、通常、10~2

【0029】また重縮合の方法としては、m-クレゾー ル、p-クレゾール、フェノール類A、アルデヒド類等 を反応の進行と共に加えていく方法等を挙げることがで

【0030】重縮合終了後、系内に存在する未反応原 料、酸性触媒および反応媒質を除去するために、一般的 に内温を130~230℃に上昇させ、減圧下、例え ば、20~50mmHg程度で揮発分を溜去し、樹脂A を回収する。また重縮合終了後、樹脂を溶解できる溶 20 媒、例えばメチルアルコール、エチルセロソルブアセテ ート、ジオキサン等に反応混合物を溶解し、水、n-へ キサン、n-ヘプタン等の沈殿剤を添加することによっ て、樹脂Aを析出させ、析出物を分離して回収すること もできる。さらに樹脂Aを回収する際、溶媒と沈殿剤の 比率を変えることにより、高分子成分や低分子成分を分 別することができ、この方法で得た樹脂を使用すること もできる。

【0031】このようにして得られる樹脂Aのポリスチ レン換算重量平均分子量(以下、「Mw」という)は、 【0025】前記重縮合反応に用いられる酸性触媒とし 30 2,000~20,000であることが好ましく、3,0 $0.0 \sim 1.5, 0.00$ であることがさらに好ましい。Mw が20,000を越えると、現像性および感度が低下す る傾向がみられ、またMwが2,000以下であると、 耐熱性が低下する傾向がみられる。

> 【0032】本発明の組成物に用いられる1,2-キノ ンジアジド化合物としては、ヒドロキシ化合物、例えば 上記一般式(B)

[0033]

【化7】

... (B)

ここで、R3、R4およびR5は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素 数1~3のアルキル基、アルコキシ基、芳香環を1~2個有し且つ置換基 を有していてもよい芳香族基を表わし、a、b, c, dおよびnは同一も しくは異なり、0~3の整数である。但しc+d=1~4である、

【0034】で表わされる化合物B、下記一般式(C) *【化8】 [0035]

> (HO) (OH),

... (C)

ここで、R11およびR12は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素 数1~3のアルキル基またはアルコキシ基を表わし、p、q, rおよびs は $0\sim5$ の整数である。但 $Up+q=2\sim6$ 、 $r+s=0\sim5$ である、

【0036】で表わされる化合物Cまたはヒドロキシフ ラバン系化合物と1,2ーナフトキノンジアジドー4ま たは5-スルホン酸クロリドとの縮合物を用いることが できる。具体的には、以下の化合物を挙げることができ

【0037】1,1-ピス(2-ヒドロキシフェニル) メタン、1-(2-ヒドロキシフェニル)-1-(4-ロキシフェニル) メタン、1,1-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) エタン、2,2-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル) プロパン、1,1,1-トリス(2-ヒドロキシ フェニル) メタン、1,1-ビス(2-ヒドロキシフェ ニル) -1-(4-ヒドロキシフェニル) メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-(2-ヒド ロキシフェニル) メタン、1,1,1-トリス(4-ヒド ロキシフェニル) メタン、1,1,1-トリス(2-ヒド ロキシフェニル) エタン、1,1-ピス(2-ヒドロキ シフェニル) -1- (4-ヒドロキシフェニル) エタ 30 【式1】 ン、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-※

※(2-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1,1-トリス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1,1-ビス(4 ーヒドロキシフェニル) -1-[4-{1-(4-ヒド ロキシフェニル) -1-メチルエチル} フェニル] エタ ン、2,3,4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2,3, 4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノン、3'ーメ トキシー2,3,4,4'ーテトラヒドロキシベンゾフェ ヒドロキシフェニル) メタン、1.1-ピス(4-ヒド 20 ノン、2.4.4-トリメチル-2',4',7-トリヒド ロキシー2-フェニルフラバン等の1,2-ナフトキノ ン-4-スルホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノ ンジアジドー5ースルホン酸エステル。

10

【0038】これらの1,2-+ノンジアジド化合物は 1種単独でまたは2種以上混合して用いられる。なお 1,2-キノンジアジドのエステル化率は50モル%~ 100モル%が好ましい。なお、エステル化率は下記式 (1) から算出される。

[0039]

エステル化率 (%) = $\frac{1.2-+1ンジアジドスルホニル基のモル数}{1.2-+1ンジアジドスルホニル基のモル数} × 100$ ヒドロキシ化合物のエステル化前の ヒドロキシ基のモル数

【0040】1,2-キノンジアジド化合物の配合量 は、樹脂Aと化合物Bとの総量100重量部に対して、 5~75重量部であり、好ましくは10~50重量部で ある。1,2-キノンジアジド化合物の配合量が少なす ぎると、放射線照射部と放射線未照射部とのアルカリ水 溶液からなる現像度に対する溶解性に差をつけにくく、 パターニングが困難となり、また配合量が多すぎると、 短時間の放射線照射では加えた1,2-キノンジアジド 化合物の全てを分解することが出来ずアルカリ水溶液か らなる現像液による現像が困難となる。

【0041】本発明の組成物は、樹脂A、化合物B、 1,2-キノンジアジドを前記一般式(I)で表わされ る構造を有する溶剤を含む溶剤に溶解させることにより 得ることができる。

【0042】本発明の組成物には、放射線に対する感度 を向上させるために増感剤を配合することもできる。こ 50 エチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシエチレ

れらの増感剤としては、例えば、2H-ピリドー(3, 2-b)-1,4-オキサジン-3(4H)-オン類、 10H-ピリドー(3,2-b)-(1,4)-ベンゾチ アジン類、ウラゾール類、ヒダントイン類、パルピツー ル酸類、グリシン無水物類、1-ヒドロキシベンゾトリ 40 アゾール類、アロキサン類、マレイミド類等が挙げられ る。これらの増感剤の配合量は、1,2-キノンジアジ ド化合物100重量部に対して通常50重量部以下であ

【0043】また本発明の組成物には、塗布性、例えば ストリエーションや乾燥塗膜形成後の放射線照射部の現 像性を改良するために界面活性剤を配合することもでき る。界面活性剤としては、例えばポリオキシエチレンラ ウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテ ル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、ポリオキシ

ンノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジ ラウレート、ポリエチレングリコールジステアレート、 エフトップEF301、EF303、EF352 (新秋 田化成社製)、メガファックF171、F172、F1 73 (大日本インキ社製)、フロラードFC430、F C431(住友スリーエム社製)、アサヒガードAG7 10、サーフロンS-382、SC-101、SC-1 02, SC-103, SC-104, SC-105, S C-106 (旭硝子社製)、オルガノシロキサンポリマ -KP341 (信越化学工業社製) アクリル酸系または 10 に制約されるものではない。 メタクリル酸系(共)重合体ポリフローNo.75、N o.90、No.95 (共栄社油脂化学工業社製)等が挙 げられる。これらの界面活性剤の配合量は、組成物の固 形分100重量部当たり、通常、2重量%以下である。

【0044】さらに本発明の組成物には、放射線照射部 を可視化させ、放射線照射時のハレーションの影響を少 なくするための染料、例えば1,7-ビス(3-メトキ シー4-ヒドロキシフェニル)-1,6-ヘプタジエン -3,5-ジオン等のβ-ジケトン構造を有する染料、 5-ヒドロキシー4-(4-メトキシフェニルアゾ) - 20 3-メチル-1-フェニルピラゾール等のピラゾールま たはイミダゾール構造を有する染料や顔料および接着性 を改良するための接着助剤を配合することもできる。

【0045】また本発明の組成物には、必要に応じて保 存安定剤、消泡剤等も配合することができる。

【0046】本発明の組成物をシリコンウェハー等の基 板に塗布する方法としては、前記樹脂A、化合物B、 1,2-キノンジアジド化合物および一般式(I)で表 わされる構造を有する溶剤、並びに各種配合剤の所定量 を、例えば固形分濃度が20~40重量%となるように 30 溶解させ、例えば、孔径0.2μm程度のフィルターで 濾過した後、これを回転塗布、流し塗布、ロール塗布等 により塗布する方法があげられる。

【0047】本発明の組成物の現像液としては、例えば 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、 硅酸ナトリウム、メタ硅酸ナトリウム、アンモニア水等 の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン 等の第一級アミン類、ジエチルアミン、ジーnープロピ ルアミン等の第二級アミン類、トリエチルアミン、メチ ルジエチルアミン等の第三級アミン類、ジメチルエタノ 40 ハー上にレジストパターンを形成させ、NSR1755 ールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミ ン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラ エチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等の第四級ア ンモニウム塩またはピロール、ピペリジン、1,8-ジ アザビシクロー(5.4.0)-7-ウンデセン、1,5 -ジアザビシクロー(4.3.0)-5-ノナン等の環状 アミン類を溶解してなるアルカリ水溶液が使用される。 また該現像液には、水溶性有機溶媒、例えばメタノー ル、エタノール等のアルコール類や界面活性剤を適量添 加して使用することもできる。

12

【0048】また本発明の組成物をポジ型レジストとし て使用するときの効果をより高めるために、シリコンウ エーハ上に本発明の組成物を塗布し、プレベークおよび 露光を行った後、70~140℃で加熱してから現像す ることができ、さらに70~140℃で加熱しながら、 紫外線を照射することもできる。

[0049]

【実施例】以下、本発明を合成例および実施例により詳 しく説明するが、本発明はこれらの合成例および実施例

【0050】実施例中のMwの測定およびレジスト性能 の評価は下記の方法によって行なった。

【0051】Mw:東洋ソーダ社製GPCカラム(G2 000H6 2本、G3000H6 1本、G4000H6 1本) を用い、流量1.5m1/分、溶出溶媒テトラヒ ドロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポ リスチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマト グラフ法により測定した。

【0052】感度:ニコン製-NSR1755G7A縮 小投影露光機 (レンズの開口係数: 0.54、g線露光 機)またはNSR150516A縮小投影露光機(レン ズの開口係数: 0.45、i線露光機) にて露光時間を 変化させて、露光を行ない、次いでテトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド2.4重量%水溶液を用い25℃で 60秒間現像し水でリンスした後、乾燥してウエハー上 にレジストパターンを形成させ、0.6 μmのライン・ アンド・スペースパターン (1対1) を、1対1の線幅 で形成する露光時間(以下、「最適露光時間」または 「感度」と称する)を求めた。

【0053】解像度:最適露光時間において、解像して いる最小のレジストパターンの寸法を調べた。

現像性:スカムや現像残りを調べた。

パターン形状:最適露光時間におけるレジストパターン の断面形状を走査型電子顕微鏡で調べた。添付図面の図 2にパターン形状の良し悪しを模式的に示した。

【0054】フォーカス許容性:最適露光時間で焦点深 度を変化させて、露光を行ない、次いでテトラメチルア ンモニウムヒドロキシド2.4重量%水溶液を用いて2 5℃で60秒間現像し水でリンスした後、乾燥してウエ G7A縮小投影露光機を使用の場合は、0.6 μmのラ イン・アンド・スペースパターン(1対1)の断面形状 を、NSR1505i6A縮小投影露光機を使用の場合 は、0.5 μmのライン・アンド・スペースパターン (1対1) のレジストパターンの断面形状を走査型電子 顕微鏡で調べた。レジストパターンの線幅が、最適焦点 深度(焦点深度を変化させないで形成させたレジストパ ターンの線幅を意味する。) におけるレジストパターン の線幅に対し、±0.02μm以内となる範囲をフォー 50 カス許容性とした。

【0055】保存安定性:自動微粒子計測器(HIAC ROYCO微粒子計測器) にて、0.5 μm以上の粒 径を有する微粒子の数が5個/m1になるように濾過し て得た感放射線性樹脂組成物を35℃に維持した恒温槽 に入れ3か月間保存した後、再び自動微粒子計測器に*

mークレゾール

3.5-キシレノール

37重量%ホルムアルデヒド水溶液(ホルマリン)

シュウ酸・2水和物

を仕込み、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を1 00℃に保ち、攪拌しながら35分間、重縮合を行った※

mークレゾール

3,5ーキシレノール

を加え、さらに120分間重縮合を行ない、樹脂を合成 した。反応後、油浴の温度を180℃まで上げ、同時に 反応容器内の圧力を30~40mmHgまで減圧し、 水、シュウ酸、未反応のホルムアルデヒド、m-クレゾ ール、3,5-キシレノールを除去した。次いで、溶融 した樹脂を室温に戻して回収した。この樹脂を、エチル 20 【0057】合成例2 セロソルプアセテートに固形分が20重量%となるよう★

mークレゾール

2.3.5-トリメチルフェノール

ホルマリン

シュウ酸・2水和物

を仕込み、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を1 00℃に保ち、攪拌しながら60分間、重縮合を行った☆

mークレゾール

2, 3, 5 -

した。反応後、油浴の温度を180℃まで上げ、同時に 反応容器内の圧力を30~40mmHgまで減圧し、 水、シュウ酸、未反応のホルムアルデヒド、m-クレゾ ール、2,3,5ートリメチルフェノールを除去した。次◆

mークレゾール

pークレゾール

3,5-キシレノール

ホルマリン

00℃に保ち、攪拌しながら60分間、重縮合を行った*

シュウ酸・2水和物

を仕込み、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を1 40*後、

mークレゾール

3,5ーキシレノール

を加え、さらに120分間重縮合を行ない、樹脂を合成 した。反応後、油浴の温度を180℃まで上げ、同時に 反応器内の圧力を30~40mmHgまで減圧し、水、 シュウ酸、未反応のホルムアルデヒド、m-クレゾー ル、p-クレゾール、3,5-キシレノールを除去し

mークレゾール

pークレゾール

14

*て、0.5 μm以上の粒径を有する微粒子の数(個/m 1) を測定した。

【0056】合成例1

攪拌機、冷却管および温度計を装着したセパラブルフラ スコに、

27.0g (0.250モル)

52.2g(0.427モル)

130.3g (1.605モル) および

0.731g (0.00580モル)

108.0g (0.999モル)

13.1g(0.107モル)

★溶解したのち、この樹脂溶液の重量に対し、2倍量のメ タノールおよび等量の水を加えて、攪拌放置した。2層 に分離したのち、樹脂溶液(下層)をとり出し、濃縮・ 脱水・乾燥して樹脂Aを回収した(以下、この樹脂を 「樹脂A (1)」と称する)。

合成例1と同様なセパラブルフラスコに、

104.0g(0.962モル)

14.0g (0.103モル)

125.3g (1.544モル)

1.558g (0.0120モル)

☆後、

26.0g(0.240モル)

56.1g (0.412モル)

を加え、さらに120分間重縮合を行ない、樹脂を合成 30◆いで、合成例1と同じ操作を繰り返し、樹脂Aを回収し た(以下、この樹脂を「樹脂A(2)」と称する)。

【0058】合成例3

合成例1と同様なセパラブルフラスコに、

19.3g(0.178モル)

38.5g(0.356モル)

52.2g (0.428モル)

137.3g(1.693モル) および

0.731g (0.00580モル)

77.0g(0.713モル)

13.0g(0.107モル)

た。次いで、合成例1と同じ操作を繰り返し、樹脂Aを 回収した(以下、この樹脂を「樹脂A(3)」と称す

【0059】合成例4

合成例1と同様なセパラブルフラスコに、

45.0g (0.416モル)

110.0g (1.172モル)

ホルマリン

シュウ酸・2水和物

150.0g (1.849モル) および 0.233g (0.00185モル)

*後、

を仕込み、セパラブルフラスコを油浴に浸し、内温を1 00℃に保ち、攪拌しながら90分間、重縮合を行った*

mークレゾール

45.0g(0.713モル)

を加え、さらに90分間重縮合を行ない、樹脂を合成し た。反応後、油浴の温度を180℃まで上げ、同時に反 応器内の圧力を30~40mmHgまで減圧し、水、シ ュウ酸、未反応のホルムアルデヒド、m-クレゾール、※

※p-クレゾールを除去した。次いで、合成例1と同じ操 作を繰り返し、樹脂Aを回収した(以下、この樹脂を 「樹脂A(4)」と称する)。

16

【0060】実施例1

樹脂A(1)

80g

化合物B(1)

1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン

(以下、1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-

フェニルエタンを化合物B(1)と略す) 20g

化合物C(1)(1,2-キノンジアジド化合物)

ポリフローNo.90

0.02g

ピルビン酸エチル

334g

30g

を混合し、溶解させた後、孔径0.1μmのメンプラン フィルターで濾過し、本発明の組成物溶液を調製した。

ー上に塗布した後、ホットプレート上で90℃にて2分

★し、露光し、次いで、110℃にて1分間ペークし、現 像してレジストパターンを形成した。このレジストパタ 得られた溶液をシリコン酸化膜を有するシリコンウエハ 20 ーンを走査型電子顕微鏡で観察した。結果を表1に示 す。

間プレベークして厚さ1.2 μmのレジスト膜を形成★

樹脂A(2)

80g

【0061】 実施例2

化合物B(2)

1,1-ピス(4-ヒドロキシフェニル)-1-[4-{1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル}フェニル]

エタン(以下、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-

[4-{1-(4-ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル}

フェニル] エタンを化合物B(2)と略す)

20 g

化合物 C(2)(1,2-キノンジアジド化合物)

30g

ポリフローNo.90 ピルピン酸エチル

0.02g334g

を混合し、溶解させた後、孔径0.1 µmのメンプラン ☆能を試験した。結果を表1に示す。

フィルターで濾過し、本発明の組成物溶液を調製した。

【0062】実施例3

得られた溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性☆

樹脂A(3)

80g

化合物B(3)

20g

1.1.1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン

(以下、1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル) エタン

を化合物B (3) と略す)

20g 30g

化合物 C(2)(1,2-キノンジアジド化合物)

0.02g

ポリフローNo.90 ピルピン酸エチル

334g能を試験した。結果を表1に示す。

を混合し、溶解させた後、孔径0.1μmのメンプラン フィルターで濾過し、本発明の組成物溶液を調製した。

【0063】実施例4

得られた溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性

樹脂A(2)

80g

化合物B(2)

20g

化合物 C (3) (1,2-キノンジアジド化合物)

30g

ポリフローNo.90

0.02g

ピルビン酸エチル

334g

18

を混合し、溶解させた後、孔径 $0.1\,\mu\,\mathrm{m}$ のメンプラン *能を試験した。結果を表 1に示す。フィルターで濾過し、本発明の組成物溶液を調製した。 【0.064】実施例 5

得られた溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性*

樹脂A (4)80g化合物B (1)20g化合物C (3) (1,2ーキノンジアジド化合物)30gポリフローNo.900.02gピルピン酸エチル334g

を混合し、溶解させた後、孔径 $0.1\,\mu\mathrm{m}$ のメンプラン 10 能を試験した。結果を表 1に示す。

フィルターで濾過し、本発明の組成物溶液を調製した。

[0065]

得られた溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性 【3

19

		BithA	化合物B	化合物C	強門	界面配約				レジスト	レジスト性的抗熱結果	執	
		種類 [Mw] ※加車	編 液 液 扩	極極終行動	極性	上	照析光	殿	解數度	现像性,	現象性バターンの形状	フォーカス野な井	保存
								nesc	# ED			μπ	画
地图1	<u> </u>	A (1) [7900]	1 B (1)	C (1)	E P 334	PF 0.02	b0	370	0.40	颇	朗	2.5	က
地面2		A (2) [8100]	1 B (2)	C (1)	3 5 5 4 7 6	PF 0.02	ы	380	0.40	鲸	調	2.4	ശ
海蜀3	I	A (3) [8900] 80	1 B (3)	C (2)	35 33 4	PF 0.02		410	0.36	齑	超	2.5	4
對極關 4		A (2) [8100] 80	J B (2)	c (3)	EP 334	PF 0.02		360	0.36	瞰	衉	2.3	63
对图 5		A (4) [6700]	J В (1) 20	C (3)	EP 334	PF 0.02		370	0.38	崩	避	2.2	4
大学 (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5		実施別1~2は2線 (436m)、実施別3~5は1線 (365m)で露光した。 111−ピス (4−ヒ ト゚ロキシフェニル) → 1−フェニルエグン	8数(436m)、実時図3~5 ーピス(4ード・ロキシフェニー ーピス(4ード・ロキシフェニー メチルエチル フェール エタン 1ートリス(4ード・ロキシフ 4,4 ーデトラヒドロキシフ ・ナフトキノンジアジドーラー ・ナフトキノンジアジドーラー ・オートリス(4ード・ロキシス ・オートリス(4ード・ロキシス ・オートリス(4ード・ロキシス ・オートリス(4ード・ロキシス ・オートリス(4ード・ロキシス ・オートリス(4ード・ロキシス ・エン・オーン・スカション・メテルエール メチルエチル)フェール エタ・メスルホン酸クロリド(2モル)と ビルビン酸エチルの略。 F90はポリフローNo.90(4)	、実種圏3~5は1級(365m ドロキシフェニル)ー1ーフェニー フェニル」エタン 4ーヒドロキシフェニル)エタン ラヒドロキシフェニル)エタン ラヒドロキシフェニル)エタン グアジドー5ースルネン酸グロリ 4ーヒドロキンフェニル)エタン(1・ジアジドー5ースルキン酸グロリ インドでキシフェニル)エタン(1・ジアジドー5ースルキン酸クロリ ジアジドー5ースルキン酸クロリ ジアジドー5ースルキン酸クロリ ジアジドー5ースルキン酸クロリ ジアンドー5ースルキン酸クロリ ジアンドー5ースルキン酸のロリ フェニル」エタン(1モル)と1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・1・	後(365) (36	3 6 rm)、実担例3~5は1線(3 6 5 rm)で配出した。 (4 ー ドロキンフェニル) - 1 ーフェニルエケン (4 ー ドロキンフェニル) - 1 ー 「4 ー (1 ー (4 ー ドロキンフェニル) エケン リス (4 ー ドロキンフェニル) エケン リス (4 ー ドロキンフェニル) エケン ーテトラヒドロキンフェニル) エケン ーテトラヒドロキンフェニル) エケン トナノンジアジドー5ースルポン酸ケロリド(3・3 モル) との縮合物。 リス (4 ー ドロキンフェニル) エケン(1 モル)と キナノンジアジドー5ースルポン酸ケロリド(2 モル)との縮合物。 (4 ー ドロキンフェニル) ー 1 ー [4 ー (1 ー (4 ー ドロキンフェール) エケン(1 モル)と1・2 ーナフトキノンジアジドー 酸フロリド(2 モル)との縮合物。 ポリフローNo・9 の(共栄社補間に学工業社製)の略。	た。 ーヒドロキシ シリンとの結合物 したドロキシャーヒドロキシャーレンジアジ	部光した。 ン・(4 - ヒドロキシフェニル) と (4 - ヒドロキシフェニル) と (4 - ヒドロキシフェニル) ・(4 - ヒドロキシフェニル) ・(4 - ヒドロキシフェニル) ・(4 - ヒドロキシフェニル) ・(4 - ヒドロキシフェニル) ・(4 - ヒドロキシフェニル)	(4/=== (4/====			·	

【0066】比較例1

数1 フジスト在都の起始結果

樹脂A (1) 80g 20g 化合物B(1)

化合物C(1)(1,2-キノンジアジド化合物) 30g ポリフローNo.90 0.02g

エチルセロソルプアセテート

334g

を混合し、溶解させた後、孔径0.1μmのメンプラン フィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。得られた

した。結果を表2に示す。 【0067】比較例2

溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性能を試験

樹脂A(2)

80g

【表2】

22

21 化合物B(2) 20g 化合物C(1)(1,2-キノンジアジド化合物) 30g ポリフローNo.90 0.02gメチルセロソルプアセテート 334g を混合し、溶解させた後、孔径0.1μmのメンプラン *した。結果を表2に示す。 フィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。得られた 【0068】比較例3 溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性能を試験* 樹脂A(3) 80g 化合物B(3) 20g 化合物 C (3) (1, 2-キノンジアジド化合物) 30g ポリフローNo.90 0.02g3-メトキシプロピルアセテート 334g を混合し、溶解させた後、孔径0.1μmのメンプラン ※した。結果を表2に示す。 フィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。得られた 【0069】比較例4 溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性能を試験※ 樹脂A (2) 80g 20g 化合物B(2) 化合物C(2)(1,2-キノンジアジド化合物) 30gポリフローNo.90 0.02g3-メチル-3-メトキシブチルアセテート 334g を混合し、溶解させた後、孔径 0.1μ mのメンプラン した。結果を表2に示す。 フィルターで濾過し、組成物溶液を調製した。得られた [0070]

溶液を用いて実施例1と同じ方法でレジスト性能を試験

--1234---

23

表2 レジスト生物の対象結果

		IsithA	化合物B	化合物C	海型	界面活生剤				レジスト	レジスト性能は統結果	誰	
		種類 [Mw] ※計畫	機器	翻翻	極級	が上野が上野	照外先	殿	解像度	現像性	現象性にケーンの形状	フォーカス群な井	野田
				(重量)		_	•	IRSEC	μm			μш	
4	比数到1	比較別1 A (1) [7900] B (1) 80)] B (1)	C (1)	ECA 334	PF. 0.02	bo	34.0	0.50	避	不良	1.5	162
<i>0</i> 【図	H 数别 2	H校例2 A (2) [8100] B (2) 80) B (2)	C (1)	MCA 334	PF 0.02	ы	370	370 0.55	嵹	與	1.5	>103
面の簡	比較到3	A (3) [8900] B (3) 80)] B (3)	0 (3) 3 0	MPA 334	PF . 0.02		400	1 400 0.45	不良	颠	1.5	>10³
単な説明	比较剧4	出致例4 A (2) [8100] B (2) 80)] B (2)	0 (S) 3 0	MBA 334	PF 0.02	1,000	350	350 0.45	碓	酸	1.5	>10°
1)	田袋里 (1)	比較例1~2はg線(436m)、比較例3~4はi線(365m)で露光した。 B (1)、B (2)、B (3)、C (1)、C (2)、C (3)、溶剤Dおよび界面活性剤は表1と同じ。	611)、五数 3)、C (1	2013~4は)、C(2)	1線(36)、C(3)	5m) C網光	した。よび網	語地類	1表1 と同	<u>រ</u> ំ			

[0071]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、高解 像度で現像性が良好で、かつフォーカス許容性とパター ン形状にすぐれ、しかも保存安定性に優れたポジ型ホト レジストに好適である。

【図1】 本発明で用いられるアルカリ可溶性ノボラッ ク樹脂の好ましい組成割合を示している。

【図2】 レジストパターンの断面形状の模式図であ る。

